

## 2SD965

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 " )

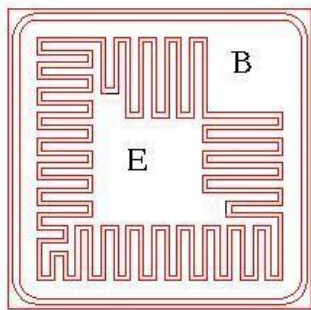
■用途:

- \*中等功率放大器
- \*中速开关应用

■特征:

- \*集电极电流: 3A
- \*有效图形数: 6700

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1050 μ m × 1050 μ m
压焊区尺寸	基 区 310 μ m × 310 μ m 发射区 320 μ m × 320 μ m
芯片厚度	225 ± 10 μ m
锯片槽宽度	70 μ m
金属层	正面: Al 2.7 ± 0.2 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=100 \mu A, I_E=0$	40		V
集电极--发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=1mA, I_B=0$	20		V
发射极--基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=10 \mu A, I_C=0$	7		V
集电极--基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=0.8BV_{CBO}, I_E=0$		100	nA
发射极--基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=7V, I_C=0$		100	nA
直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=2V, I_C=0.5A$	200	900	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3A, I_B=0.1A$		1.0	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=6V, I_C=50mA, f=10MHz$	150		MHz
结电容	$C_{ob}$	$V_{CB}=20V, I_E=0, f=1MHz$		50	pF